

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005 年 4 月 7 日 (07.04.2005)

PCT

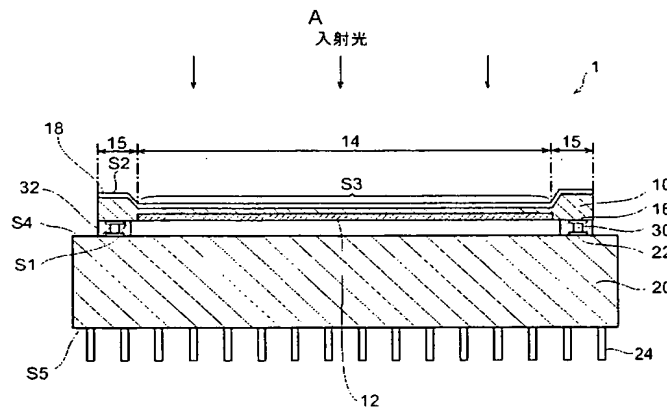
(10) 国際公開番号
WO 2005/031872 A1

- (51) 国際特許分類: H01L 27/14, 31/02, 21/56, 21/60 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/013965 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小林 宏也
(22) 国際出願日: 2004 年 9 月 24 日 (24.09.2004) (KOBAYASHI, Hiroya) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜
(25) 国際出願の言語: 日本語 松市市野町 1 1 2 6 番地の 1 浜松ホトニクス株
(26) 国際公開の言語: 日本語 式会社内 Shizuoka (JP). 村松 雅治 (MURAMATSU,
Masaharu) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野
(30) 優先権データ: 特願2003-333690 2003 年 9 月 25 日 (25.09.2003) JP 町 1 1 2 6 番地の 1 浜松ホトニクス株式会社内
Shizuoka (JP).
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 浜松ホト
ニクス株式会社 (HAMAMATSU PHOTONICS K.K.) (74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA, Yoshiki et al.);
[JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野町 1 1 2 6 番地 〒1040061 東京都中央区銀座一丁目 1 0 番 6 号 銀座
の 1 Shizuoka (JP). ファーストビル 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,

[続葉有]

(54) Title: SEMICONDUCTOR DEVICE AND PROCESS FOR MANUFACTURING THE SAME

(54) 発明の名称: 半導体装置及びその製造方法



A...INCIDENT LIGHT

(57) Abstract: A semiconductor device in which high precision focusing for a photodetecting part and uniformity and stability of high sensitivity at the photodetecting part can be maintained by preventing the thinned part of a semiconductor substrate from bending or cracking. The semiconductor device (1) comprises a semiconductor substrate (10), a wiring board (20), conductive bumps (30), and a resin (32). A CCD (12) and a thinned part (14) are formed on the semiconductor substrate (10). An electrode (16) of the semiconductor substrate (10) is connected with an electrode (22) of the wiring board (20) through the conductive bump (30). The gap between a peripheral part (15) surrounding the thinned part (14) and the wiring board (20) is filled with the insulating resin (32) in order to reinforce the bonding strength of the conductive bump (30). The resin (32) is a resin sheet which is previously so shaped as to circumferentially surround the gap between the thinned part (14) and the wiring board (20) while leaving a part of the circumference of the gap unsurrounded.

(57) 要約: この半導体装置では、半導体基板の薄型化部分の撓み及び割れを防止し、光検出部に対する高精度なフォーカシング及び光検出部における高い感度の均一性及び安定性を維持することができる。半導体装置 1 は、半導体基板 10、配線基板 20、導電性バンプ 30、及び樹脂 32 を備える。半導体基板 10 には CCD 12 と薄型化部分 14 とが形成され

[続葉有]



DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

ている。半導体基板10の電極16は、導電性バンプ30を介して配線基板20の電極22と接続されている。薄型化部分14の外縁部15と配線基板20との間の空隙には、導電性バンプ30の接合強度を補強するため、絶縁性の樹脂32が充填されている。この樹脂32は、薄型化部分14と配線基板20との間の空隙の周囲をその周囲の一部を残して囲むように予め成形された樹脂シートである。